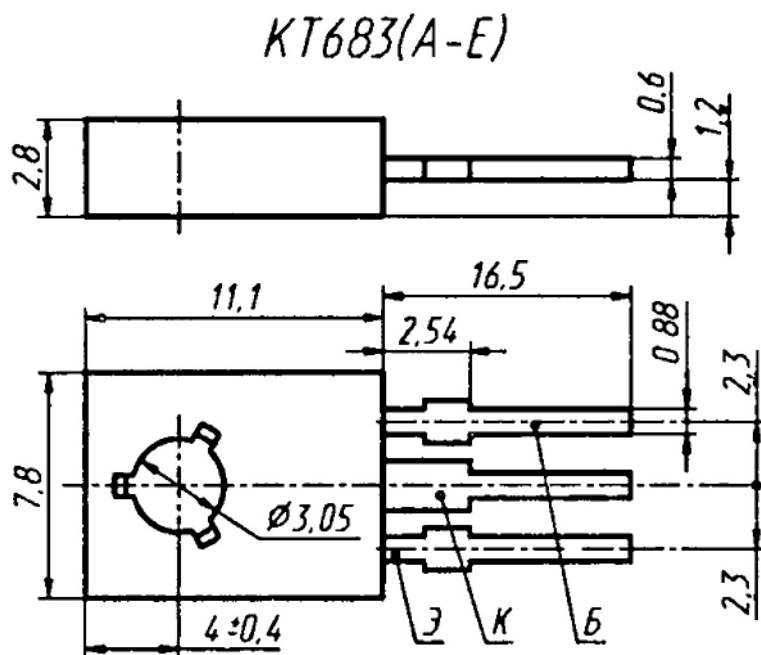


## КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ} = 10$  В,  $I_k = 0,15$  А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г .....	40...120
КТ683Б, КТ683Д .....	80...240
КТ683Е .....	160...480

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кб} = 10$  В,  $I_3 = 50$  мА, не менее .....

50 МГц

Граничное напряжение при  $I_3 = 30$  мА, не менее:

КТ683А .....	90 В
КТ683Б, КТ683В .....	80 В
КТ683Г .....	60 В
КТ683Д, КТ683Е .....	40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при  $I_k = 0,15$  А,  $I_б = 15$  мА, не более .....

0,45 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при  $I_k = 0,15$  А,  $I_б = 15$  мА, не более .....

1 В

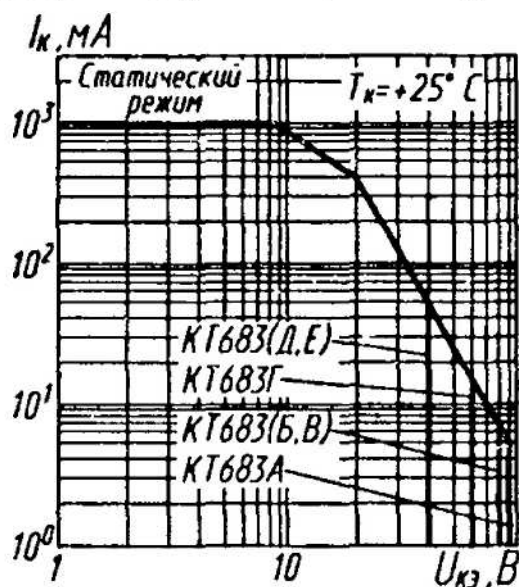
Пробивное напряжение коллектор—эмиттер		
при $I_k = 0,1$ мА, $R_{БЭ} = 3$ кОм, не менее:		
КТ683А .....	150 В	
КТ683Б, КТ683В .....	120 В	
КТ683Г .....	100 В	
КТ683Д, КТ683Е .....	60 В	
Пробивное напряжение база—эмиттер		
при $I_3 = 0,1$ мА, не менее:		
КТ683А, КТ683Б, КТ683В .....	7 В	
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е .....	5 В	
Время включения при $U_{кэ} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, типовое значение .....	0,1* мкс	
Время выключения при $U_{кэ} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_Б = 40$ мА, типовое значение .....	0,2* мкс	
Емкость коллекторного перехода		
при $U_{кб} = 10$ В, не более .....	15* пФ	
Емкость эмиттерного перехода		
при $U_{зб} = 0,5$ В, не более .....	65* пФ	
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 90$ В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более .....		1 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

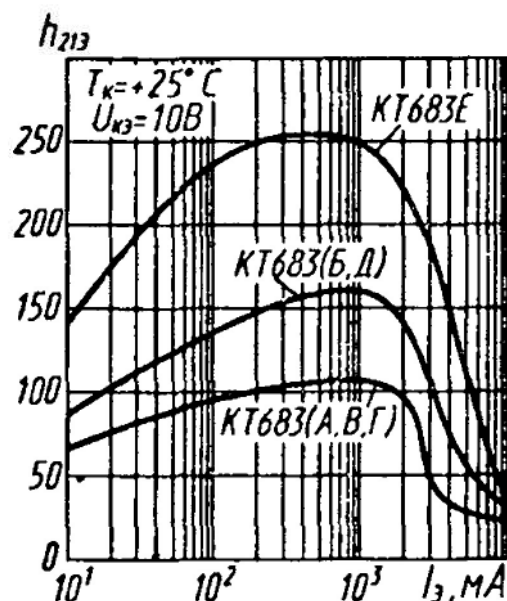
Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ683А .....	150 В
КТ683Б, КТ683В .....	120 В
КТ683Г .....	100 В
КТ683Д, КТ683Е .....	60 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
при $R_{БЭ} = 3$ кОм:	
КТ683А .....	150 В
КТ683Б, КТ683В .....	120 В
КТ683Г .....	100 В
КТ683Д, КТ683Е .....	60 В
при $R_{БЭ} = \infty$ :	
КТ683А .....	90 В
КТ683Б, КТ683В .....	80 В
КТ683Г .....	60 В
КТ683Д, КТ683Е .....	40 В
Постоянное напряжение база—эмиттер:	
КТ683А, КТ683Б, КТ683В .....	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е .....	5 В

Постоянный ток коллектора .....	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 1$ мс.....	2 А
Постоянный ток базы .....	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T_{к} = -60...+25$ °С:	
с теплоотводом .....	8 Вт
без теплоотвода .....	1,2 Вт
Температура р-п перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-60... $T_{к} =$ = +125 °С

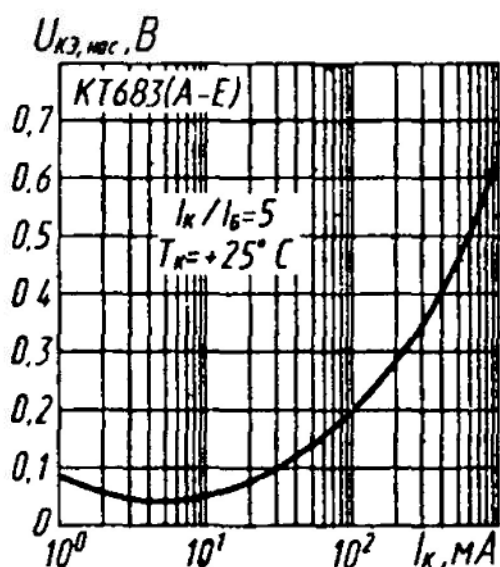
<sup>1</sup> При  $T_{к} \geq 25$  °С  $P_{к, макс}$  снижается линейно на 0,064 Вт/°С с теплоотводом и на 0,0096 Вт/°С без теплоотвода.



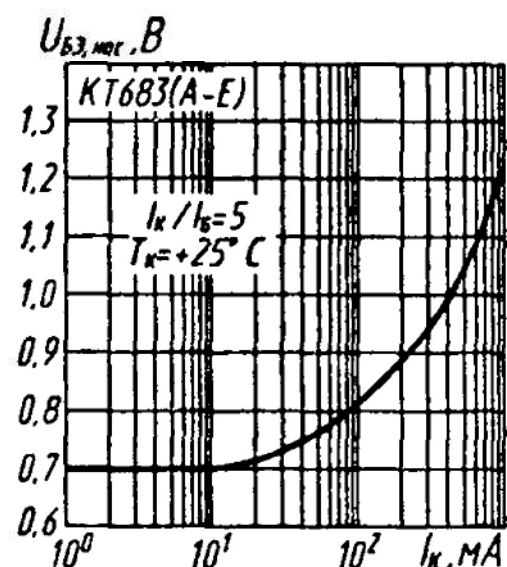
Области безопасной работы транзисторов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора